

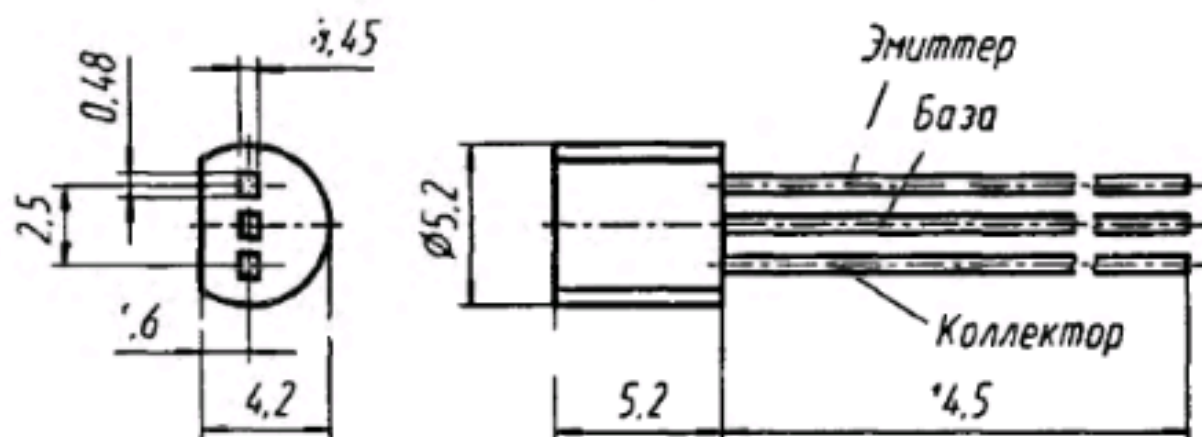
## КТ345А, КТ345Б, КТ345В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $p-n-p$  универсальные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты, импульсных и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. На корпусе наносится условная маркировка — две цветные точки: КТ345А — белая и розовая; КТ345Б — белая и желтая; КТ345В — белая и синяя.

Масса транзистора не более 0,3 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Рига.

### КТ345(А-В)



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кз} = 1$  В,  $I_3 = 100$  мА:

КТ345А .....	20...60*
КТ345Б .....	50...85*
КТ345В .....	70...105*

Граничная частота коэффициента передачи тока при  $U_{кз} = 5$  В,  $I_3 = 10$  мА, не менее .....

350 МГц

Время рассасывания при  $I_k = 100$  мА,

$I_{б1} = I_{б2} = 10$  мА, не более .....

70 нс

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер

при  $I_k = 100$  мА,  $I_б = 10$  мА .....

0,14\*...0,3 В

Напряжение насыщения база—эмиттер

при  $I_k = 100$  мА,  $I_б = 10$  мА .....

0,92\*...1,1 В

Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 20$  В,

не более .....

0,5 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{эб} = 5$  В,

не более .....

0,5 мкА

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5$ В, не более .....	15 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$ , не более .....	30 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база и коллектор—эмиттер при $R_{бэ} \leq 10$ кОм .....	20 В
Постоянное напряжение эмиттер—база .....	5 В
Постоянный ток коллектора .....	200 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора <sup>1</sup> :	
при $T \leq +30$ °С .....	300 мВт
при $T = +85$ °С .....	162,5 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность .....	600 мВт
Тепловое сопротивление переход—среда .....	0,4 °С/мВт
Температура р-п перехода .....	+150 °С
Температура окружающей среды .....	-40...+85 °С

<sup>1</sup> В диапазоне температур +30...+85 °С допустимые значения рассеиваемой мощности снижаются линейно.

Изгиб выводов транзисторов допускается не ближе 5 мм от корпуса с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимальное расстояние от места пайки выводов до корпуса 5 мм при температуре пайки не выше +250 °С и длительности не более 10 с. Температура корпуса при пайке не должна превышать +150 °С.